

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年10月21日(2004.10.21)

【公表番号】特表2000-501238(P2000-501238A)

【公表日】平成12年2月2日(2000.2.2)

【出願番号】特願平9-520270

【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 33/00

H 0 1 L 29/20

H 0 1 L 29/43

H 0 1 S 5/32

【F I】

H 0 1 L 33/00 A

H 0 1 S 3/18 6 7 2

H 0 1 L 29/20

H 0 1 L 29/46 G

【手続補正書】

【提出日】平成15年11月18日(2003.11.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

手続補正書

平成15年11月18日



特許庁長官 殿

1. 事件の表示 平成9年特許願第520270号

2. 補正をする者

名 称 キネティック・リミテッド

3. 代 理 人 東京都新宿区新宿1丁目1番11号 友泉新宿御苑ビル
(郵便番号 160-0022) 電話(03)3354-8623
(6200) 弁理士 川 口 義 雄

4. 補正命令の日付 自 発

5. 補正により増加する請求項の数 なし

6. 補正対象書類名 請求の範囲

7. 補正対象項目名 請求の範囲

8. 補正の内容

(1) 請求の範囲を別紙の通り補正する。



別紙

請 求 の 範 囲

1. ドープされたn型材料(5)の第一層との接合を形成するp型またはn型材料の活性層(4)と、他の層、p型またはn型材料の前記活性層(4)に隣接する又はそれから分離されたドープされたp型材料(2)の層に隣接するドープされたn型材料(11)の第二層と、ドープされたn型材料(11)の第二層を介して、ドープされたp型材料(2)に隣接する層に電気接点を提供する手段を含む、デバイスに電気接点を提供する手段とを備える半導体デバイスであって、
活性層(4)の半導体エネルギーバンドギャップが0.5 eV以下であり、ドープされたn型材料(11)の第二層が、バンドギャップのエネルギーよりも大きいエネルギーの、このデバイスによって放出または吸収される放射に対して透明であることを特徴とする半導体デバイス。
2. 前記デバイスが、前面発光プラスLEDまたはマイナスLEDまたは検出器を備える請求の範囲第1項に記載のデバイス。
3. 前記デバイスが、裏面発光プラスLEDまたはマイナスLEDまたは検出器を備え、ドープされたn型材料(11)の第二層を介してドープされたp型材料(2)に隣接する層に電気接点を提供する手段が、金属接点(6)を備え、ドープされたn型材料(11)の第二層が、透明な前面接触領域を提供して、金属接点(6)をミラーとして使用するのを容易にする請求の範囲第1項に記載のデバイス。
4. 前記デバイスが、レーザダイオード(14)を備え、ドープされたn型材料(5; 11)の第一層および第二層が活性層(4)内の光閉じ込めを提供する請求の範囲第1項に記載のデバイス。
5. ドープされたn型材料(11)の第二層が、排他接触または抽出接触(6)への電気経路を提供する請求の範囲第1項に記載のデバイス。
6. 前記デバイスが、電界効果トランジスタを備える請求の範囲第5項に記載のデバイス。
7. 前記デバイスが、バイポーラトランジスタを備える請求の範囲第5項に記載のデバイス。